

ベクトル解析 追試験問題

具体的な計算過程も全て記すこと。

I. $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ として、次の微分演算の結果がスカラーかベクトルかを答え、その値を求めよ。

$$(1) \nabla \cdot \mathbf{r} \quad (2) \nabla \times \mathbf{r} \quad (3) \nabla \frac{1}{r} \quad (4) \nabla \cdot \left(\nabla \frac{1}{r} \right) \quad (5) \nabla \times \left(\nabla \frac{1}{r} \right)$$

II.

(1) C^2 級のスカラー場 $\phi(x, y, z)$ について、次のことを示せ。

$$\nabla \times (\nabla \phi) = 0.$$

(2) C^2 級のベクトル場 $\mathbf{A}(x, y, z)$ について、次のことを示せ。

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0.$$

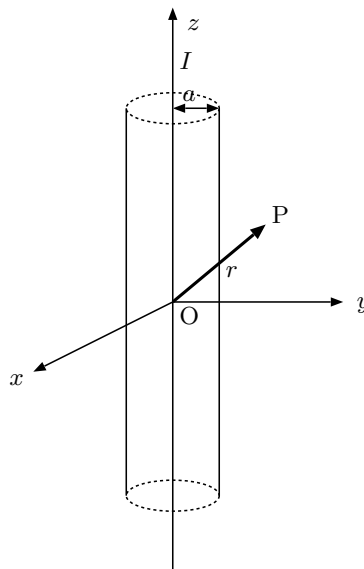
II. 図のように無限に長い中空の円筒の表面に大きさ I の定常電流が流れている。円筒の断面は、半径 a の円であるとする。電流は円筒表面を一様に流れているとし、円筒の中心軸を z 軸とする。また、電流の向きを z 軸の正の方向とする。

磁場を \mathbf{H} 、電流密度を \mathbf{i} としたとき、マクスウェルの方程式の一つは、

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i}$$

で与えられる。円筒座標 $\mathbf{r} = (\rho, \phi, z)$ の点 P における、定常電流による磁場 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ を考える。

- (1) 点 P における磁場の向きを理由とともに答えよ。
- (2) 以下の領域における磁場の大きさを求めよ。
 - (a) 円筒の外側 ($a < \rho$)
 - (b) 円筒の内側 ($\rho < a$)



III. 図のように，真空中に，電荷 Q が一様に分布している半径 R の球が置かれている。球の中心を原点 O として下図のように座標系をとる。電場を \mathbf{E} ，電荷密度を ρ ，真空の誘電率を ϵ_0 としたとき，マックスウェルの方程式の一つは，

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1)$$

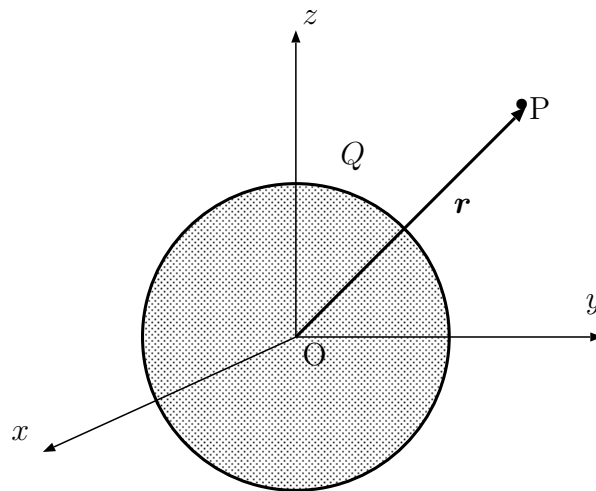
で与えられる。

(1) 座標 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ の点 P における電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ の向きを理由とともに答えよ。

(2) 式(1)とガウスの定理を用いることにより，電場の大きさを以下の場合について求めよ。

(a) 球の外側 ($R < r$) (b) 球の内部 ($r < R$)

ここで， $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ である。



IV. 球座標系において，曲線座標は $(q_1, q_2, q_3) = (r, \theta, \phi)$ である。以下の問いに答えよ。

1. デカルト座標系での座標 (x, y, z) を球座標系の座標 (r, θ, ϕ) で表せ。

2. $i = 1, 2, 3$ について， $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ を計算せよ。

3. $\mathbf{f}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ ， $h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$ とする。 h_1, h_2, h_3 を求めよ。また， $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3$ は規格直交系をなすことを示せ。

V. 次のことを証明せよ。

1. エルミート行列の異なる固有値に属する固有ベクトルは直交する。ただし，エルミート行列の固有値は実数ということは既知とする。

2. エルミート行列はユニタリ行列で対角化できる。ただし，簡単のため，エルミート行列の固有値は縮退していないとする。